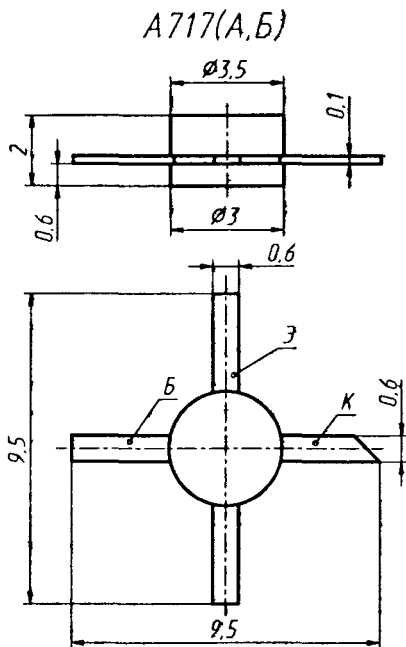


A717A, A717B

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 3,6 ГГц. Предназначены для применения во входных и последующих каскадах усилителей сверхвысоких частот с расширенным динамическим диапазоном в составе гибридных интегральных микросхем, микросборках, обеспечивающих герметизацию и защиту транзисторов от воздействия влаги, соляного тумана, плесневых грибов, пониженного и повышенного давления и солнечной радиации. Бескорпусные на кристаллодержателе с гибкими выводами. Транзисторы маркируются условным обозначением, знаком «V» у базового вывода: A717A — синего цвета, A717B — черного цвета. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.



Электрические параметры

Минимальный коэффициент шума на $f = 3,6$ ГГц при $U_{КБ} = 7$ В, $I_3 = 20$ мА, не более	4 дБ
Оптимальный коэффициент усиления по мощности на $f = 3,6$ ГГц при $U_{КБ} = 7$ В, $I_3 = 20$ мА, не менее	7 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 7$ В, $I_3 = 20$ мА, не менее:	
А717А	40
А717Б	80
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В, не более	1 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 1$ В, не более	20 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база	10 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	1 В
Потенциал статического электричества	30 В
Постоянный ток коллектора	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T_K = -60...+60$ °С	350 мВт
Тепловое сопротивление переход—корпус	250 °С/Вт
Температура окружающей среды	-60... T_K = = +125 °С

¹ При $T_K > +60$ °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{K, \text{макс}} = (175 - T_K) / 250, \text{ Вт.}$$

Допускается пайка выводов на расстоянии 1 мм от кристаллодержателя серебряно-индиевыми припоями и другими, не приводящими к возникновению интерметаллических соединений при температуре пайки не выше +260 °С в течение не более 3 с. Допускается пайка на расстоянии не менее 0,2 мм от кристаллодержателя при температуре пайки не выше +160 °С в течение не более 3 с. Допускается использование только бескислотного флюса.

Допускается однократный изгиб выводов с радиусом закругления 1,5 мм на расстоянии 1 мм от кристаллодержателя. Допускается обрезать выводы на расстоянии не менее 1 мм от кристаллодержателя.

Разрешается проводить монтаж транзисторов в гибридной схеме припайкой металлизированного основания кристаллодержателя к теплоотводящей поверхности при температуре пайки не выше +180 °С.